Mẫu số 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.....

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ☑; Nội dung không đúng thì để trống: ☐)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ☑; Giảng viên thỉnh giảng ☐

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Khoa học vật liệu

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Văn Chương

2. Ngày tháng năm sinh: 10/11/1986; Nam ☑; Nữ ☐; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☑

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: xã Phong Vân, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Căn hộ 507, tòa CT2-C2, Khu nhà ở Đài PSPT Mễ Trì, tổ dân phố 1, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Nguyễn Văn Chương, Bộ môn Vật liệu và CNVL, Phòng 1116, nhà S1, Học viện Kỹ thuật Quân sự, số 236 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0981586598;

E-mail: chuongnguyen11@gmail.com

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ năm 2016 đến năm 2020: Giáo viên tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

Chức vụ: Hiện nay: Giáo viên; Chức vụ cao nhất đã qua: Giáo viên

Cơ quan công tác hiện nay: Học viện Kỹ thuật Quân sự

Địa chỉ cơ quan: số 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại cơ quan:

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Không có

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH ngày 18 tháng 6 năm 2012, ngành: Khoa học Vật liệu, chuyên ngành: Khoa học Vật liệu
Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia sông Đông, Liên bang Nga.
- Được cấp bằng TS ngày 12 tháng 11 năm 2015, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý trạng thái ngưng tụ
Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Tổng hợp miền Nam Liên bang Nga, Liên bang Nga.

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Học viện Kỹ thuật Quân sự

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Nghiên cứu các tính chất điện tử và truyền dẫn của vật liệu nano graphene và hiệu ứng tiếp xúc giữa graphene với bề mặt các vật liệu bán dẫn hướng tới các ứng dụng điện tử và quang điện tử.

- Nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện tử, truyền dẫn và quang học của các vật liệu hai chiều và cấu trúc vật liệu xếp lớp van der Waals

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng) 3 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai);
- Đã hoàn thành 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước;
- Đã công bố (số lượng) 94 bài báo KH, trong đó 86 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 1, trong đó 0 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng 0 tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế.

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Giải thưởng Nghiên cứu trẻ	Hội vật lý lý thuyết	2017
2	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở	Học viện Kỹ thuật Quân sự	2018
3	Giáo viên dạy tốt	Học viện Kỹ thuật Quân sự	2018
4	Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	Học viện Kỹ thuật Quân sự	2018

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá):

Trong thời gian là cán bộ giảng dạy của Học viện Kỹ thuật Quân sự, tôi luôn cố gắng thực hiện đúng các nhiệm vụ của Nhà giáo cụ thể như sau:

+ Gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, các quy định của Pháp luật và điều lệ Nhà trường;

+ Luôn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý, chương trình giáo dục;

+ Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của Nhà giáo;

+ Tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học;

+ Quan hệ tốt và luôn hỗ trợ các đồng nghiệp trong các công việc của Bộ môn và trong Khoa;

Tôi tự nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn của một Nhà giáo:

+ Không ngừng học tập và trau dồi các phẩm chất đạo đức và tư tưởng, đã được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

+ Về mặt chuyên môn, tôi luôn phấn đấu nâng cao trình độ nghiệp vụ của một nhà giáo. Tôi cũng rất đam mê với công tác nghiên cứu khoa học và coi đó là một công việc hết sức quan trọng của một giảng viên đại học.

+ Đảm bảo sức khỏe để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên *:

- Tổng số 4 năm.
- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

(Căn cứ chế độ làm việc đối với giảng viên theo quy định hiện hành)

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ giảng trực tiếp/Số giờ quy đổi/Số giờ định mức
		Chính	**Phụ**			**ĐH**	**SĐH**	
1								
2								
3	7/2016 - 6/2017				2	285		285/310/270
3 năm học cuối								
4	7/2017 - 6/2018			2		270		270/410/270
5	7/2018 - 6/2019			1		285		285/355/270
6	7/2019 - 6/2020					380		380/380/270

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Nga, Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài ☑:

- Học ĐH ☑; Tại nước: Liên bang Nga; Từ năm 2006 đến năm 2012

- Bảo vệ luận văn ThS ☐ hoặc luận án TS ☑ hoặc TSKH ☐; Tại nước: Liên bang Nga năm 2015

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ☐:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ☐:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ☐; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): TOEIC 600

4. Hướng dẫn NCS, học viên CH, BSCK, BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Vũ Thanh Tuyền		X	X		09/2017 đến 05/2018	Trường Đại học sư phạm Huế	2018
2	Nguyễn Phú Cường		X	X		09/2017 đến 05/2018	Trường Đại học sư phạm Huế	2018
3	Phan Thị Hằng		X	X		08/2018 đến 06/2019	Trường Đại học sư phạm Huế	2019

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai số lượng NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDĐH (số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ							
1	Магнетизм и транспортные свойства нанолент графена на полупроводниковых подложках	CK	Nhà xuất bản trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật quốc gia sông Đông, năm 2016	2	VC		Số 1854/GCN-HV

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS: 0

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					

1	Nghiên cứu tính chất điện tử và truyền dẫn của graphene trên các lớp đế bán dẫn: Ảnh hưởng của biến dạng và điện trường ngoài	CN	103.01-2016.07, cấp Nhà nước	28/4/2017 đến 28/4/2019	Ngày 25 tháng 1 năm 2019; Kết quả Đạt

Lưu ý:

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS;

Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)

7.1. Bài báo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
1	Edge and substrate-induced bandgap in zigzag graphene nanoribbons on the hexagonal boron nitride 8-ZGNR/h-BN(0001)	5	Có	AIP Advances/ ISSN: 2158-3226	Q2 - SCIE ***IF: 1.579***	6	3 , 9, 092105 (9 trang)	2013

2	Краевые эффекты в двухслойных нанолентах графена типа зигзаг: Ab initio изучение методом функционала плотности	3	Không	Proceedings of the 16-th International meeting on Order, Disorde and Properties of Oxides, 7-12 September 2013, Rostov on Don, Russia/ ISBN: 978-5-87872-726-6			, 146-149	2013
3	Переход полупроводник-полуметалл-металл в бислое нанолент графена на гексагональном нитриде бора: эффект внешнего электрического поля	2	Có	Proceedings of the International meeting on Low dimensional systems, 15-19 September 2014, Rostov on Don, Russia/ ISBN: 978-5-241-01121-3			, 50-53	2014
4	Переход полупроводник-полуметалл-металл в бислое нанолент графена на гексагональном нитриде бора: эффект одноосной деформации	2	Có	Proceedings of the 17-th International meeting on Order, Disorde and Properties of Oxides, 5-10 September 2014, Rostov on Don, Russia/ISBN: 978-5-9905703-7-5			, 129-132	2014

5	Magnetism and transport properties of zigzag graphene nanoribbons/hexagonal boron nitride heterostructures.	4	Có	Journal of Applied Physics/ ISSN: 0021-8979	Q2 - SCI ***IF: 2.328***	17	115 , 5, 053708 (6 trang)	2014
6	Ab initio study of structural and electronicproperties of zigzag graphene nanoribbons on hexagonal boron nitride	5	Không	Journal of Structural Chemistry/ ISSN: 0022-4766	- Scopus ***IF: 0.541***	3	55 , 2, 191-200	2014
7	Tuning the bandstructure, magnetic and transport properties of the zigzag graphenenanoribbons/hexagonal boron nitride heterostructures by transverse electricfield.	4	Có	Journal of Chemical Physics/ ISSN: 0021-9606	Q1 - SCI ***IF: 2.997***	26	141 , 1, 014708 (8 trang)	2014
8	Semiconductor–halfmetal–metal transition and magnetism of bilayer graphenenanoribbons/hexagonal boron nitride heterostructure.	4	Có	Solid State Communications/ ISSN: 0038-1098	Q2 - SCI ***IF: 1.433***	6	199 , 1-10	2014
9	Modulation of the band structure in bilayer zigzag graphenenanoribbons on hexagonal boron nitride using the force and electric fields.	5	Có	Materials Chemistry and Physics/ ISSN: 0254-0584	Q2 - SCI ***IF: 2.781***	4	154 , 78-83	2015
10	Dispersion-Corrected Density Functional Theory Investigations of Structural and Electronic Properties of Bulk MoS2: Effect of Uniaxial Strain	3	Có	Nanoscale Research Letters/ ISSN: 1931-7573	Q1 - SCIE ***IF: 3.159***	7	10 , 1, 433 (8 trang)	2015
11	Tuning the electronic properties of armchair graphene nanoribbons by strain engineering	3	Có	Physica Scripta/ ISSN: 1402-4896	Q2 - SCI ***IF: 2.151***	3	90 , 1, 015802 (7 trang)	2015

12	Effect of electric field on the electronic and magnetic properties of graphene nanoribbon/aluminium nitride bilayer system.	4	Có	RSC Advances/ ISSN: 2046-2069	Q1 - SCIE ***IF: 3.049***	6	5 , 61, 49308-49316	2015
13	Electric field and substrate–induced modulation of spin-polarized transport ingraphene nanoribbons on A3B5 semiconductors.	4	Có	Journal of Applied Physics/ ISSN: 0021-8979	Q2 - SCI ***IF: 2.328***	6	117 , 17, 174309 (8 trang)	2015
14	Substrate-induced band structure and electronic properties in graphene/Al2O3 (0001) interface	5	Có	Surface Science/ ISSN: 0039-6028	Q2 - SCI ***IF: 1.849***	2	632 , 111-117	2015
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
15	Modulation the Band Structure and Physical Properties of the Graphene Materials with Electric Field and Semiconductor Substrate	6	Có	Spinger Proceeding in Physics/ ISBN: 978-3-319-26322-9	- Scopus		175 , 279-297	2016
16	Transport propertiesof armchair graphene nanoribbons under uniaxial strain: A first principles study	4	Có	Solid State Communications/ ISSN: 0038-1098	Q2 - SCI ***IF: 1.433***	1	237 , 10-13	2016
17	Effect of biaxial strain and external electric field on electronic properties of MoS2 monolayer: A first-principle study	2	Có	Chemical Physics/ ISSN: 0301-0104	Q2 - SCI ***IF: 1.822***		468 , 9-14	2016

18	Ảnh hưởng của biến dạng và điện trường ngoài đến tính chất điện tử của hệ graphene-molybdenum disulfide	6	Có	Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ X/ ISBN: 978-604-95-0325-2			1 , 171-173	2017
19	Nghiên cứu các tính chất điện tử của cấu trúc dị thể graphene-Al2O3	2	Có	Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học sư phạm Huế/ ISSN: 1859-1612			42 , 2, 54-60	2017
20	Out-of-plane strain and electric field tunable electronic properties and Schottky contact of graphene/antimonene heterostructure	6	Có	Superlattices and Microstructures/ ISSN: 0749-6036	Q2 - SCI ***IF: 2.328***	10	112 , 554-560	2017
21	Band gap and electronic properties of molybdenum disulphide under strain engineering: Density functional theory calculations	3	Có	Molecular Simulation/ ISSN: 0892-7022	Q2 - SCIE ***IF: 1.782***	5	43 , 2, 86-91	2017
22	Laser-Induced Engineering of Surface Structures and Properties on Oxygen-Adsorbed TiC(111) Surface: First-Principles Calculations	9	Không	Springer Proceedings in Physics/ ISBN: 978-3-319-78918-7	- Scopus		207 , 127-144	2017
23	First-principles study of electronic properties of AB-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out-plane strain	6	Có	Indian Journal of Physics/ ISSN: 0973-1458	Q3 - SCIE ***IF: 1.242***		92 , 4, 447-452	2018

24	Tuning the electronic properties, effective mass and carrier mobility of MoS2 monolayer by strain engineering: First-principle calculations	13	Có	Journal of Electronic Materials/ ISSN: 0361-5235	Q2 - SCI ***IF: 1.676***	16	47 , 1, 730-736	2018
25	First principle study on the electronic properties and Schottky contact of graphene adsorbed on MoS2 monolayer under applied out-plane strain	5	Có	Surface Science/ ISSN: 0039-6028	Q2 - SCI ***IF: 1.849***	10	668 , 23-28	2018
26	Electric-field tunable electronic properties and Schottky contact of graphene/phosphorene heterostructure	4	Có	Vacuum/ ISSN: 0042-207X	Q2 - SCI ***IF: 2.515***	6	149 , 231-237	2018
27	First principles study of optical properties of molybdenum disulfide: From bulk to monolayer	8	Có	Superlattices and Microstructures/ ISSN: 0749-6036	Q2 - SCI ***IF: 2.385***	10	115 , 10-18	2018
28	Tuning the electronic properties and Schottky barrier height of the vertical graphene/MoS2 heterostructure by an electric gating	1	Có	Superlattices and Microstructures/ ISSN: 0749-6036	Q2 - SCI ***IF: 2.385***	10	116 , 79-87	2018
29	van der Waals Heterostructure of Graphene and Gallium Selenide: Tuning the Electronic Properties and Schottky Barrier Height by Interlayer Coupling, Biaxial Strain and Electric Gating	5	Có	Journal of Alloys and Compounds/ ISSN: 0925-8388	Q1 - SCI ***IF: 4.175***	13	75 , 765-773	2018

30	First principles study of the electronic properties and band gap modulation of two-dimensional phosphorene monolayer: Effect of strain engineering	5	Có	Superlattices and Microstructures/ ISSN: 0749-6036	Q2 - SCI ***IF: 2.385***	3	118 , 289-297	2018
31	Tuning the Electronic and Optical Properties of Two-Dimensional Graphene-like C2N Nanosheet by Strain Engineering	10	Có	Journal of Electronic Materials/ ISSN: 0361-5235	Q2 - SCI ***IF: 1.676***	5	47 , 8, 4594-4603	2018
32	Interlayer coupling and electric field tunable electronic properties and Schottky barrier in graphene/bilayer-GaSe van der Waals heterostructure	4	Có	Physical Chemistry Chemical Physics/ ISSN: 1463-9076	Q1 - SCI ***IF: 3.567***	34	20 , 26, 17899-17908	2018
33	Ab-initio study of electronic and optical properties of biaxially deformed single-layer GeS	10	Có	Superlattices and Microstructures/ ISSN: 0749-6036	Q2 - SCI ***IF: 2.385***	5	120 , 501-507	2018
34	Effect of strains on electronic and optical properties of monolayer SnS: Ab-initio study	12	Có	Physica B: Condensed Matter/ ISSN: 0921-4526	Q2 - SCI ***IF: 1.874***	4	545 , 255-261	2018
35	Electronic properties of GaSe/MoS2 and GaS/MoSe2 heterojunctions from first principles calculations	5	Có	AIP Advances/ ISSN: 2158-3226	Q2 - SCIE ***IF: 1.579***	4	8 , 7, 075207 (9 trang)	2018
36	First principles calculations on the geometric structures and electronic properties of van der Waals heterostructure based on graphene, hexagonal boron nitride and molybdenum diselenide	2	Có	Diamond and Related Materials/ ISSN: 0925-9635	Q1 - SCI ***IF: 2.29***	3	88 , 151-157	2018

37	LO-phonon-assisted cyclotron resonance in a special asymmetric hyperbolic-type quantum well	6	Có	Superlattices and Microstructures/ ISSN: 0749-6036	Q2 - SCI ***IF: 2.385***	8	120 , 738-746	2018
38	First principles study of the electronic properties and Schottky barrier in vertically stacked graphene on the Janus MoSeS under electric field	7	Có	Computational Materials Science/ ISSN: 0927-0256	Q1 - SCI ***IF: 2.644***	21	153 , 438-444	2018
39	Theoretical investigation of hot electron cooling process in GaAs/AlAs cylindrical quantum wire under the influence of an intense electromagnetic wave	7	Không	Optical and Quantum Electronics/ ISSN: 0306-8919	Q3 - SCIE ***IF: 1.547***		50 , 9, 342-351	2018
40	Phonon-assisted cyclotron resonance in special symmetric quantum wells	6	Không	Applied Physics A/ ISSN: 0947-8396	Q2 - SCI ***IF: 1.784***	6	124 , 9, 656 (8 trang)	2018
41	First principles study on the electronic properties and Schottky barrier of Graphene/InSe heterostructure	8	Có	Superlattices and Microstructures/ ISSN: 0749-6036	Q2 - SCI ***IF: 2.385***	7	122 , 570-576	2018
42	Electronic structure, optical and photocatalytic performance of SiC-MX2 (M= Mo, W and X=S, Se) van der Waals heterostructures	8	Không	Physical Chemistry Chemical Physics/ ISSN: 1463-9076	Q1 - SCI ***IF: 3.567***	18	20 , 37, 24168-24175	2018
43	First-principles study of W, N, and O adsorption on TiB2(0001) surface with disordered vacancies	9	Không	Superlattices and Microstructures/ ISSN: 0749-6036	Q2 - SCI ***IF: 2.385***	4	123 , 414-426	2018

44	Magneto-optical absorption in quantum dot via two-photon absorption process	9	Có	Optik, ISSN: 0030-4026	Q2 - SCI ***IF: 1.914***		173 , 263-270	2018
45	Layered graphene/GaS van der Waals heterostructure: Controlling the electronic properties and Schottky barier by vertical strain	7	Có	Applied Physics Letters/ ISSN: 0003-6951	Q1 - SCI ***IF: 3.521***	55	113 , 15, 171605 (5 trang)	2018
46	Structural and electronic properties of van der Waals heterostructure based on silicene and gallium selenide: Effect of strain and electric field	7	Có	Physical Chemistry Chemical Physics/ ISSN: 1463-9076	Q1 - SCI ***IF: 3.567***	25	20 , 44, 27856-27864	2018
47	Nonlinear optical absorption and cyclotron-impurity resonance in monolayer silicene	7	Không	Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures/ ISSN: 1386-9477	Q2 - SCI ***IF: 3.176***		105 , 168-173	2019
48	Modulation of electronic properties of monolayer InSe via strain and external electric field	8	Có	Chemical Physics/ ISSN: 0301-0104	Q2 - SCI ***IF: 1.822***	4	516 , 213-217	2019
49	Magneto-electronic perturbation effects on the electronic phase of phosphorene	7	Không	Materials Research Express/ ISSN: 2053-1591	Q2 - SCIE ***IF: 1.449***		6 , 6, 026102 (7 trang)	2019
50	Modulation of electronic properties and Schottky barrier in the graphene/GaS heterostructure by electric gating	3	Có	Physica B: Condensed Matter/ ISSN: 0921-4526	Q2 - SCI ***IF: 1.874***		555 , 69-73	2019

51	Theoretical investigation of electronic structure and thermoelectric properties of MX2 (M=Zr, Hf; X=S, Se) van der Waals heterostructures	9	Không	Journal of Physics and Chemistry of Solids/ ISSN: 0022-3697	Q2 - SCI ***IF: 2.752***	4	126 , 304-309	2019
52	Vertical strain and electric field tunable electronic properties of type-II band alignment C2N/InSe van der Waals heterostructure	10	Có	Chemical Physics Letters/ ISSN: 0009-2614	Q2 - SCI ***IF: 1.901***	7	716 , 155-161	2019
53	Opening a band gap in graphene by C–C bond alternation: A tight binding approach	9	Không	Materials Research Express/ ISSN: 2053-1591	Q2 - SCIE ***IF: 1.449***	2	6 , 4, 045605 (8 trang)	2019
54	One- and two-photon-induced cyclotron-phonon resonance in modified Pöschl-Teller quantum well	7	Không	Applied Physics A/ ISSN: 0947-8396	Q2 - SCI ***IF: 1.784***	3	125 , 3, 166-175	2019
55	Strain and electric field tunable electronic properties of type-II band alignment in van der Waals GaSe/MoSe2 heterostructure	6	Không	Chemical Physics/ ISSN: 0301-0104	Q2 - SCI ***IF: 1.822***	3	521 , 92-99	2019
56	Tailoring electronic properties and Schottky barrier in sandwich heterostructure based on graphene and tungsten diselenide	7	Có	Diamond and Related Materials/ ISSN: 0925-9635	Q1 - SCI ***IF: 2.29***	8	94 , 129-136	2019
57	Controlling electronic properties of PtS2/InSe van der Waals heterostructure via external electric field and vertical strain	4	Có	Chemical Physics Letters/ ISSN: 0009-2614	Q2 - SCI ***IF: 1.901***	8	724 , 1-7	2019

58	Strain engineering and electric field tunable electronic properties of Ti2CO2 MXene monolayer	12	Có	Materials Research Express/ ISSN: 2053-1591	Q2 - SCIE ***IF: 1.449***	1	6 , 6, 065910 (8 trang)	2019
59	Electric field tunable electronic properties of P-ZnO and SiC-ZnO Van der Waals heterostructures	5	Không	Computational Materials Science/ ISSN: 0927-0256	Q1 - SCI ***IF: 2.644***	5	164 , 166-170	2019
60	Two-photon induced magneto-optical absorption in finite semi-parabolic quantum wells	6	Không	Superlattices and Microstructures/ ISSN: 0749-6036	Q2 - SCI ***IF: 2.385***		130 , 446-453	2019
61	Tri-layered van der Waals heterostructures based on Graphene, Gallium Selenide and Molybdenum Selenide	8	Có	Journal of Applied Physics/ ISSN: 0021-8979	Q2 - SCI ***IF: 2.328***	3	125 , 22, 225304 (8 trang)	2019
62	Cyclotron-phonon resonance line-width in monolayer silicene	8	Không	Superlattices and Microstructures/ ISSN: 0749-6036	Q2 - SCI ***IF: 2.385***	3	131 , 117-123	2019
63	Strain and electric field engineering of electronic structures and Schottky contact of layered graphene/Ca(OH)2 heterostructure	7	Có	Superlattices and Microstructures/ ISSN: 0749-6036	Q2 - SCI ***IF: 2.385***	2	133 , 106185 (8 trang)	2019
64	Strain and electric field engineering of band alignment in InSe/Ca(OH)2 heterostructure	7	Có	Chemical Physics Letters/ ISSN: 0009-2614	Q2 - SCI ***IF: 1.901***		732 , 136649 (7 trang)	2019
65	Computational understanding of electronic properties of graphene/PtS2 heterostructure under electric field	3	Có	Applied Physics A/ ISSN: 0947-8396	Q2 - SCI ***IF: 1.784***	2	125 , 8, 536 (7 trang)	2019

66	Phonon-assisted cyclotron-resonance in Pöschl-Teller quantum well	6	Không	Journal of Applied Physics/ ISSN: 0021-8979	Q2 - SCI ***IF: 2.328***	2	126 , 12, 124301 (9 trang)	2019
67	Tailoring the structural and electronic properties of SnSe2/MoS2 van der Waals heterostructure by electric field and the insertion of graphene sheet	7	Có	Physical Chemistry Chemical Physics/ ISSN: 1463-9076	Q1 - SCI ***IF: 3.567***	5	21 , 39, 22140-22148	2019
68	Rashba spin splitting and photocatalytic properties of GeC-MSSe (M=Mo, W) van der Waals heterostructures	7	Có	Physical Review B/ ISSN: 2469-9950	Q1 - SCI ***IF: 3.736***	15	100 , 16, 165425 (9 trang)	2019
69	Band alignment and optical features in Janus-MoSeTe/X(OH)2 (X = Ca, Mg) van der Waals heterostructures	10	Có	Physical Chemistry Chemical Physics/ ISSN: 1463-9076	Q1 - SCI ***IF: 3.567***	6	21 , 46, 25849-25858	2019
70	Electronic and optical properties of Janus ZrSSe by density functional theory	8	Không	RSC Advances/ ISSN: 2046-2069	Q1 - SCIE ***IF: 3.049***	3	9 , 70, 41058-41065	2019
71	Schottky anomaly and Neel temperature treatment of possible perturbed hydrogenated AA-stacked graphene, SiC, and h-BN bilayers	9	Không	RSC Advances/ ISSN: 2046-2069	Q1 - SCIE ***IF: 3.049***	2	9 , 71, 41569-41580	2019

72	Computational understanding of the band alignment engineering in PbI2/PtS2 heterostructure: Effects of electric field and vertical strain	7	Có	Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures/ ISSN: 1386-9477	Q2 - SCI ***IF: 3.176***	2	115 , 113706 (5 trang)	2020
73	Graphene/WSeTe van der Waals heterostructure: Controllable electronic properties and Schottky barrier via interlayer coupling and electric field	8	Có	Applied Surface Science/ ISSN: 0169-4332	Q1 - SCI ***IF: 5.155***	10	507 , 145036 (10 trang)	2020
74	Computational insights into structural, electronic and optical characteristics of GeC/C2N van der Waals heterostructures: Effects of strain engineering and electric field	10	Có	RSC Advances/ ISSN: 2046-2069	Q1 - SCIE ***IF: 3.049***		10 , 5, 2967-2974	2020
75	Magneto-optical transport properties of monolayer transition metal dichalcogenides	9	Không	Physical Review B/ ISSN: 2469-9950	Q1 - SCI ***IF: 3.736***	5	101 , 4, 045424 (13 trang)	2020
76	Stacking and electric field effects on the band alignment and electronic properties of the GeC/GaSe heterostructure	8	Không	Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures/ ISSN: 1386-9477	Q2 - SCI ***IF: 3.176***		120 , 114050 (6 trang)	2020
77	Effects of electric field and strain engineering on the electronic properties, band alignment and enhanced optical properties of ZnO/Janus ZrSSe heterostructures	9	Có	RSC Advances/ ISSN: 2046-2069	Q1 - SCIE ***IF: 3.049***		10 , 17, 9824-9832	2020

78	Magneto-optical absorption in Pöschl–Teller-like quantum well	7	Không	Physica B: Condensed Matter/ ISSN: 0921-4526	Q2 - SCI ***IF: 1.874***		592 , 412279 (6 trang)	2020
79	Electronic structure and optical performance of PbI2/SnSe2 heterostructure	10	Có	Chemical Physics/ ISSN: 0301-0104	Q2 - SCI ***IF: 1.822***		533 , 11076 (7 trang)	2020
80	First-principles prediction of chemically functionalized InN monolayers: Electronic and optical properties	10	Không	RSC Advances/ ISSN: 2046-2069	Q1 - SCIE ***IF: 3.049***		10 , 18, 10731-10739	2020
81	Embedding of atoms into the nanopore sites of the C6N6 and C6N8 porous carbon nitride monolayers with tunable electronic properties	6	Không	Physical Chemistry Chemical Physics/ ISSN: 1463-9076	Q1 - SCI ***IF: 3.567***		22 , 11, 6418-6433	2020
82	Effects of different surface functionalization on the electronic properties and contact types of graphene/Functionalized-GeC van der Waals heterostructures	9	Có	Physical Chemistry Chemical Physics/ ISSN: 1463-9076	Q1 - SCI ***IF: 3.567***		22 , 7952-7961	2020
83	Theoretical prediction of electronic and optical properties of haft-hydrogenated InN monolayers	9	Không	Superlattices and Microstructures/ ISSN: 0749-6036	Q2 - SCI ***IF: 2.385***		142 , 106519 (7 trang)	2020
84	Understanding the electronic properties, contact types and optical performances in graphene/InN heterostructure: Role of electric gating	9	Có	Diamond and Related Materials/ ISSN: 0925-9635	Q1 - SCI ***IF: 2.29***		106 , 107851 (8 trang)	2020

85	Electronic properties and enhanced photocatalytic performance of van der Waals Heterostructures of ZnO and Janus transition metal dichalcogenides	7	Có	Physical Chemistry Chemical Physics/ ISSN: 1463-9076	Q1 - SCI ***IF: 3.567***		22 , 10351-10359	2020
86	Effects of charged impurity scattering and substrate on the magneto-optical absorption properties in gapped monolayer graphene	8	Không	Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures/ ISSN: 1386-9477	Q2 - SCI ***IF: 3.176***		121 , 114149 (5 trang)	2020
87	Electronic and Photocatalytic performance of vdW Boron Phosphide-BlueP Heterostructures	7	Không	Applied Surface Science/ ISSN: 0169-4332	Q1 - SCI ***IF: 5.155***		523 , 5.155	2020
88	Magneto-optical absorption in silicene and germanene induced by electric and Zeeman fields	9	Không	Physical Review B/ ISSN: 2469-9950	Q1 - SCI ***IF: 3.736***		101 , 20, 205408 (12 trang)	2020
89	Stark and Zeeman effects on the topological phase and transport properties of topological crystalline insulator thin films	6	Không	Physical Chemistry Chemical Physics/ ISSN: 1463-9076	Q1 - SCI ***IF: 3.567***		22 , 12129-12139	2020
90	Electronic and optical properties of Janus SnSSe monolayer: Effects of strain and electric field	7	Không	Physical Chemistry Chemical Physics/ ISSN: 1463-9076	Q1 - SCI ***IF: 3.567***		22 , 20, 11637 (7 trang)	2020

91	Electronic and optoelectronic properties of van der Waals heterostructure based on graphene-like GaN, blue phosphorene, SiC, and ZnO: A first principles study	4	Có	Journal of Applied Physics/ ISSN: 0021-8979	Q2 - SCI ***IF: 2.328***		128 , (Đã chấp nhận đăng), 9 trang	2020
92	Van der Waals heterostructures of MoS2 and Janus MoSSe monolayers on graphitic boron-carbon-nitride (BC3, C3N, C3N4 and C4N3) nanosheets: A First-Principles study	5	Không	Journal of Physics D: Applied Physics/ ISSN: 1361-6463	Q1 - SCI ***IF: 2.829***		53 , 355106 (8 trang)	2020
93	Graphene hetero-multilayer on layered platinum mineral Jacutingaite (Pt2HgSe3): Van der Waals heterostructures with novel optoelectronic and thermoelectric performances	5	Không	Journal of Materials Chemistry A/ ISSN: 0959-9428	Q1 - SCI ***IF: 10.733***		Đã chấp nhận đăng ,	2020
94	Interlayer coupling and electric field controllable Schottky barriers and contact types in graphene/PbI2 heterostructure	7	Có	Physical Review B/ ISSN: 2469-9950	Q1 - SCI ***IF: 3.736***		101 , 23, 235419 (8 trang)	2020

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà UV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 47

*Lưu ý:*Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS. 7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	**Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích**	**Tên cơ quan cấp**	**Ngày tháng năm cấp**	**Tác giả chính/ đồng tác giả**	**Số tác giả**
Không có					

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế:

TT	Tên giải thưởng	Cơ quan/tổ chức ra quyết định	Số quyết định và ngày, tháng, năm	Số tác giả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ				
1	Giải thưởng Nghiên cứu trẻ	Hội Vật lý lý thuyết	02/2017/HVLLT ngày 6/7/2017	2

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: 1

7.4. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Cấp quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ	Vai trò	Cơ sở giáo dục đại học
Không có			

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm: thiếu (số lượng năm, tháng): 2 năm, 0 tháng

- Giờ giảng dạy

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ: thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ☐; 04 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH ☐

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

(*) Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm.

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2020

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)